(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-284710

(43)公開日 平成10年(1998)10月23日

(51) Int.Cl. 6		識別記号	FΙ		
H01L	27/14		H01L	27/14	D
	27/148		H 0 4 N	5/335	v
H 0 4 N	5/335		H01L	27/14	В

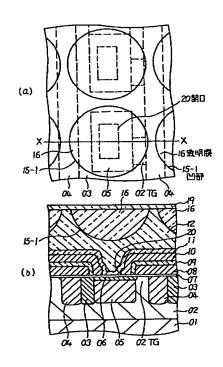
(22)出願日 平成9年(1997)4月9日 東京都港区芝五丁目7番1号 (72)発明者 小川 智弘)出顯番号 特顯平9-90579	(71)出願人 000004237 日本電気株式会社
東京都港区芝五丁目7番1号 日本 式会社内	的出願日 平成9年(1997)4月9	
(74)代理人 弁理士 京本 直樹 (外2名)		東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気
		(74)代理人 弁理士 京本 直樹 (外2名)

(54) 【発明の名称】 固体撮像素子、その製造方法及び固体撮像装置

(57)【要約】

【課題】固体撮像素子の感度を向上させるためのオンチップの機械的強度を改善し、ケースの構造を簡単にする ことであった。

【解決手段】酸化シリコン膜などからなる透明膜12に等方性エッチにより凹部15-1を形成し、この中に窒化シリコン膜でなる高屈折率の透明膜16を埋設し、上面を平坦化することによりレンズとしている。このため機械的強度が高く、耐熱性が高い。またレンズ上面に空間を必要としないため、ケースが簡素化でき、コスト低減できる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に多数配置された光電変換部上に 表面が平坦な第1の透明膜を有し、前記各光電変換部の 上にあたる位置の前記第1の透明膜に中心部にいくに従 い単調に深くなる第1の凹部をそれぞれ有し、前記各第 1の凹部に前記第1の透明膜よりも屈折率が高い第2の 透明膜がそれぞれ埋設されていることを特徴とする固体 掃像素子。

【請求項2】 第2の透明膜が単層膜である請求項1記 載の固体撮像素子。

【請求項3】 第2の透明膜が第1の透明膜よりも屈折 率が高い第3の透明膜を含む多層膜である請求項1記載 の固体撮像素子。

【請求項4】 第2の透明膜の表面が平坦である請求項 2 又は3 記載の固体撮像素子。

【請求項5】 第2の透明膜に第2の凹部を有している 請求項1,2又は3項記載の固体撮像素子。

【請求項6】 基板上に多数配置された光電変換部上に 第1の透明膜を形成する工程と、第1の透明膜を耐エッ チング性膜で被覆し前記各光電変換部の上に当たる位置 20 焦点レンズである請求項15記載の固体撮像装置。 近傍にそれぞれ開口を形成する工程と、前記第1の透明 膜を前記耐エッチング性膜の前記各開口部より等方性エ ッチングを行い前記各開口部を中心とする第1の凹部を それぞれ形成する工程と、前記各第1の凹部に前記第1 の透明膜よりも屈折率が高い第2の透明膜をそれぞれ埋 設する工程とを有することを特徴とする固体撮像素子の 製造方法。

【請求項7】 第1の凹部を形成した後第1の液状物質 を全面に塗布する工程と、前記第1の液状物質を固化さ せそれと同時に体積を縮減させ前記各第1の凹部底部に その中心に近づくにしたがい厚さが厚くなりかつ上部が 凹んでいる第2の透明膜をそれぞれ形成する工程とを有 し、前記第2の透明膜が前記第1の透明膜よりも屈折率 が高い請求項6記載の固体撮像素子の製造方法。

【請求項8】 第1の凹部を形成した後第1の液状物質 を全面に塗布する工程と、前記第1の液状物質を固化さ せそれと同時に体積を縮減させ前記各第1の凹部底部に その中心に近づくにしたがい厚さが厚くなりかつ上部が 凹んでいる第3の透明膜をそれぞれ形成し、前記各第3 の透明膜上部に第4の透明膜を埋設することにより第2 の透明膜を形成する工程とを有し、前記第3または前記 第4の透明膜の少なくとも一方が前記第1の透明膜より も屈折率が高い請求項6記載の固体撮像素子の製造方

【請求項9】 第1の液状質はシリカ塗布液である請求 項7又は8記載の固体撮像素子の製造方法。

【請求項10】 第1の透明膜の等方性エッチングに対 するエッチングレートがその表面から厚さ方向に遅くな る性質を有している請求項6記載の固体撮像素子の製造 方法。

【請求項11】 不純物濃度が表面から厚さ方向に減少 して分布している酸化シリコン膜を第1の透明膜として 形成する固体撮像素子の製造方法。

【請求項12】 酸化シリコン膜を堆積し不純物をイオ ン注入する請求項11記載の固体撮像素子の製造方法。 【請求項13】 不純物ソースガスの供給量を制御しつ つCVD法で酸化シリコン膜を堆積する請求項11記載

【請求項14】 基板上に多数配置された光電変換部上 に第1の透明膜を有し、前記各光電変換部の上にあたる 位置の前記第1の透明膜の中心部にいくに従い単調に深 くなる凹部をそれぞれ有し、前記各凹部に前記第1の透 明膜よりも屈折率が高い第2の透明膜がそれぞれ埋設さ れている固体撮像素子チップと、前記固体撮像素子チッ プの上面に密着して透明封止材が設けられていることを 特徴とする固体撮像装置。

【請求項15】 透明封止材の上面に撮影レンズが設け られている請求項14記載の固体撮像装置。

【請求項16】 撮影レンズが透明封止材と一体の固定

【発明の詳細な説明】

の固体撮像素子の製造方法。

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は固体撮像素子、その 製造方法及び固体撮像装置に関し、特に高感度の固体撮 像素子、その製造方法及び固体撮像装置に関する。

[0002]

【従来の技術】以下、現在もっと広く用いられているC CD型固体撮像素子を例にあげて説明するが、MOS型 など他の撮像素子についても同様の当てはめることがで きる。

【0003】従来、髙感度の固体撮像素子としては図1 0に示した第1の従来例があった。

【0004】この第1の従来例の固体撮像素子は、N型 シリコン基板01 (表面部にPウェル2を有している) 表面近傍にN型拡散層O5を有するフォトダイオード、 その横に読出ゲート領域02TGを介してN型の電荷転 送領域04を有し、またシリコン基板上にはゲート絶縁 膜07を有し、その上に電荷転送電極08を有し、その 上に酸化シリコン膜09をはさんで遮光膜10を有し、 40 との遮光膜 10のN型拡散層 05の上に当たる部分に開 口20を有している。更に、絶縁膜11及び平坦化膜2 1を有し、この平坦化膜21の開口20の直上に当たる 位置にオンチップレンズ22を有していた。平坦化膜2 1は通常フォトレジストなどの塗布膜を焼き固めて形成 され、またオンチップレンズ22は、リソグラフィー技 術によりフォトレジスト膜などのパターンを形成したの ち150~200℃熱硬化させ半球状にしていた。

【0005】また、第2の従来例として、図11に示し たものがあり、日本国特許特許公開平成2年第6517 50 1号公報に示されている。

【0006】これは遮光膜10と転送電極08によって 囲まれた、N型拡散層05の上のくぽみをシリカガラス 23と屈折率の高い窒化シリコン膜などで埋設し、上面 を平坦化し凸レンズ24を形成していた。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】上述した従来の固体撮 像素子のうち、現在広く用いられている第1の従来例で はオンチップレンズ22はフォトレジスト膜を熱処理す ることにより形成しているのが強度で低く、また凸状で あるので傷がつきやすくまたゴミがのこりやすく一旦ゴ 10 ミが付着すると除去が困難である。このため従来の固体 撮像素子を扱う半導体装置製造ラインは拡散終了後も組 立工程終了後までは換気の高清浄度を保つ必要があり、 ライン設備に多大な費用がかかる。

【0008】またケースに組み立てる際、レンズ22の 上は空間を設けるか、またはレンズ22にくらべ十分に 屈折率の低い物質を充填する必要がある。さもないとレ ンズ作用をしなくなる。

【0009】このためケースの構造が複雑になり高価に アーホンカメラなど安価な製品が多く、そのため固体撮 像素子のコストも低減する必要がある。ところが、従来 の固体撮像素子では上述したようにチップを載せるケー スにかなりのコストがかかり、コスト低減の妨げとなっ

【0010】また、第2の従来例では、第1の従来例の 傷がつきやすく、ゴミが付着し易い欠点は改善されるも のの凸レンズ24は電荷転送電極08で囲まれた絶縁膜 11のくばみに形成されるので、電荷転送電極08の直 上などは凸レンズ24が形成されず、この部分への入射 30 光は無駄になるので、感度が低下するという問題があ

【0011】本発明の目的は、感度を犠牲にすることな く、第1の従来例のもつ上述の問題点の改善された固体 撮像素子、その製造方法及び固体撮像装置を提供すると とにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明の固体撮像素子 は、基板上に多数配置された光電変換部上に表面が平坦 な第1の透明膜を有し、前記各光電変換部の上にあたる 位置の前記第1の透明膜に中心部にいくに従い単調に深 くなる第1の凹部をそれぞれ有し、前記各第1の凹部に 前記第1の透明膜よりも屈折率が高い第2の透明膜がそ れぞれ埋設されているというものである。

【0013】この場合、第2の透明膜は単層膜であって もよいし、第1の透明膜よりも屈折率が高い第3の透明 膜を含む多層膜であってもよい。又、第2の透明膜の表 面は平坦であってもよいし、第2の凹部を有していても

【0014】本発明の固体撮像素子の製造方法は、基板 50 折率の差を利用してレンズ作用をもたせているので、第

上に多数配置された光電変換部上に第1の透明膜を形成 する工程と、前記第1の透明膜を耐エッチング性膜で被 覆し前記各光電変換部の上に当たる位置近傍にそれぞれ 開口を形成する工程と、前記第1の透明膜を前記耐エッ チング性膜の前記各開口部より等方性エッチングを行い 前記各開口部を中心とする第1の凹部をそれぞれ形成す る工程と、前記各第1の凹部に前記第1の透明膜よりも 屈折率が高い第2の透明膜をそれぞれ埋設する工程とを 有するというものである。

【0015】この場合第1の凹部を形成した後第1の液 状物質を全面に塗布する工程と、前記第1の液状物質を 固化させそれと同時に体積を縮減させ前記各第1の凹部 底部にその中心に近づくにしたがい厚さが厚くなりかつ 上部が凹んでいる第2の透明膜をそれぞれ形成する工程 とを有し、前記第2の透明膜が前記第1の透明膜よりも 屈折率が高いものとすることができる。

【0016】更に第1の凹部を形成した後第1の液状物 質を全面に塗布する工程と、前記第1の液状物質を固化 させそれと同時に体積を縮減させ前記各第1の凹部底部 なった。最近はパソコンカメラや電子スチルカメラ、ド 20 にその中心に近づくにしたがい厚さが厚くなりかつ上部 が凹んでいる第3の透明膜をそれぞれ形成し、前記各第 3の透明膜上部に第4の透明膜を埋設することにより第 2の透明膜を形成する工程とを有し、前記第3または前 記第4の透明膜の少なくとも一方が前記第1の透明膜よ りも屈折率が高いものとすることができる。

> 【0017】更に又、第1の液状質としてシリカ塗布液 を使用することができる。

> 【0018】あるいは、第1の透明膜の等方性エッチン グに対するエッチングレートがその表面から厚さ方向に 遅くなる性質を有しているものとすることができる。

> 【0019】 この場合、不純物濃度が表面から厚さ方向 に減少して分布している酸化シリコン膜を第1の透明膜 として形成することができる。酸化シリコン膜を堆積し 不純物をイオン注入してもよいし、不純物ソースガスの 供給量を制御しつつСVD法で酸化シリコン膜を堆積し てもよい。

【0020】本発明の固体撮像装置は、基板上に多数配 置された光電変換部上に第1の透明膜を有し、前記各光 電変換部の上にあたる位置の前記第1の透明膜の中心部 40 にいくに従い単調に深くなる凹部をそれぞれ有し、前記 各凹部に前記第1の透明膜よりも屈折率が高い第2の透 明膜がそれぞれ埋設されている固体撮像素子チップと、 前記固体撮像素子チップの上面に密着して透明封止材が 設けられているというものである。

【0021】との場合、透明封止材の上面に撮影レンズ が設けられていてもよい。撮影レンズは透明封止材と一 体の固定焦点レンズであってもよい。

【0022】本発明の固体撮像素子は、第1の透明膜の 第1の凹部に埋設して第2の透明膜を設け、これらの屈 10

5

2の透明膜の表面を凸状にしなくてよい。更に、第1,第2の透明膜を無機絶縁膜とすることにより、硬質にできる。又、第2の透明膜の表面を平坦にすると、ケースに組み立てるとき、チップ上に空間を設けなくてもレンズ作用は変らない。更に、第2の透明膜に第2の凹部を設けても、屈折率差を大きくしてレンズ作用を強くしておけば、チップ上に空間を設けなくても総合的に十分なレンズ作用を保つことができる。

【0023】このような本発明の固体撮像素子を透明封止材によりケースに組み立てることができる。その場合、透明封止材と一体化して固定焦点レンズを設けることができる。

[0024]

【発明の実施の形態】図1(a)は本発明の固体撮像素子の第1の実施の形態を示す平面図、図1(b)は図1(a)のX-X線断面図である。

【0025】との実施の形態は、N型シリコン基板01 の表面部にPウェル02を有している。Pウェル02の 表面部にはP型の素子分離領域03で区画されたN型拡 散層 05 (表面にP・型拡散層 06を有している。)が 20 複数個配置されてフォトダイオード列を構成している。 このフォトダイオード列と平行にN型の電荷転送領域0 4 (埋込みチャネル)が設けられている。フォトダイオ ード列と埋込みチャネルとを含んで画素列が構成され、 複数の画素列が並列配置されて撮像領域が構成される。 各N型拡散層05と電荷転送領域04との間にそれぞれ 読出ゲート領域02TGが設けられている。読出ゲート 領域とこれに隣接する電荷転送領域04はゲート絶縁膜 07を介して第1の電荷転送電極08で被覆されてい る。第1の電荷転送電極08は画素列の各画素毎にそれ 30 ぞれ1個もうけられ、更に電荷転送領域04の走向方向 (垂直方向)と直交する方向(水平方向) に配置されて いる各画素列の第1の電荷転送電極08は相互に連結さ れている。水平方向に連結された第1の電荷転送電極の 間には第2の電荷転送電極(図示しない)が設けられて いる。

【0026】第1、第2の電荷転送電極は酸化シリコン 膜09を介して遮光膜10で被覆されている。遮光膜10にはN型拡散層04上に開口20が設けられている(ここまでの構造はCCD固体撮像素子として普通のものであり本発明に特有のものではない)。更に、絶縁膜11及び表面が平坦な第1の透明膜12を有し、第1の透明膜12のN型拡散層05(光電変換部)の直上にあたる部分に、半球面状の凹部15-1を有し、この凹部15-1に第2の透明膜16が埋設されており、第2の透明膜16の光の屈折率は第1の透明膜12の屈折率に比べ高くなっており、凸レンズを形成している。

【0027】次に、第1の実施の形態の製造方法について説明する。

【0028】まず、図2(a)に示すように、N型シリ 50 などの硬度の高いカバー膜19を形成することもでき

コン基板01表面にP型不純物を導入し、Pウェル02を形成する。次にP型の素子分離領域03、N型の電荷転送領域04、N型の拡散層05(光電変換部)、P・型領域06(N型拡散層05の表面に形成されている)をそれぞれ不純物を導入して形成する。

【0029】次に、図2(b)に示すように、酸化シリコン膜、窒化シリコン膜の多層膜または単層膜より成るゲート絶縁膜07を形成する。次に、リンなどを含むポリシリコン膜を堆積後パターニングし、第1の電荷転送電極08を形成する。次に熱酸化により第1の電荷転送電極08の表面及び側面を酸化し酸化シリコン膜を形成する。次に、ポリシリコン膜を堆積後パターニングして図示しない第2の電荷転送電極を形成し、その表面及び側面を酸化シリコン膜などで被覆したのちアルミニウム膜やタングステン膜またはこれらを積層した多層膜を例えば膜厚200nm~500nmの膜厚に堆積しパターニングを行い、遮光膜10と開口20を形成する。次に絶縁膜11を堆積する。ここまでは、ごく普通のCCD固体操像素子や第1の従来例の場合と同じである。

【0030】つぎに、図2(c)に示すように、第1の 透明膜12、例えば酸化シリコン膜を厚さ2~5μm程度に堆積する。この厚さはレンズ(16)の焦点距離などに対応して適宜決めればよい。又、第1の透明膜12にリンやボロンなどを含む酸化シリコン膜を用いれば、応力によるクラックが起きにくい。また、応力緩和のために応力の異なる多層の膜を形成してもよい。また第1の透明膜上部の平坦性を高める必要がある場合には、CMP(ケミカル・メカニカル・ボリッシュ)法により平坦化を行ってもよい。

○ 【0031】つぎに、フォトレジスト膜13により各N型拡散層05の直上にそれぞれ小さな開口14を設ける。つづいて、希フッ酸溶液などにより透明膜12に半球状のくぼみ(凹部15-1)が形成される。この等方性エッチングは、フォトレジスト膜が剥れて漂うようになる直前まで行なうことができるが、個々の製品において感度などの特性が最も良くなるように、エッチング時間を調整すればよい。透明膜12の上に窒化シリコン膜などの耐エッチング性膜(図示しない)を形成したのち、フォトレジスト膜13をマスクにこの耐エッチング性膜をエッチングすることにより開口を形成し、それをマスクに透明膜12を等方性エッチングしてもよい。

【0032】つぎに、図1に示すように、くぼみ(第1の凹部15)に透明膜16を埋設し、透明膜12とでほぼ表面が平坦になるようにする。透明膜16は窒化シリコン膜(屈折率約2.0)など透明膜12(酸化シリコン膜の屈折率は約1.6)よりも屈折率の高いものを使用する。つぎに透明膜12、16の上部をCMP法などにより平坦化するのが好ましい。つぎに窒化シリコン膜

る。

【0033】フォトレジスト膜13のパターンはN型拡 散層 05 や遮光膜 10の開口形状により適宜変更しても よい。例えば撮像素子の画素が長方形の場合、フォトレ ジスト13の開口14パターンも細長くすれば、形成さ れるレンズ17の平面形状も長円形状となり、撮像領域 に入った光を無駄なく効率的にN型拡散層 0 5 に導くと とができる。

【0034】またレンズの焦点距離は、透明膜12,1 6の屈折率の比と、第1の凹部15-1の曲率半径によ 10 透明膜12A, 16Aの屈折率の比と、凹部15-1A りきまるので、第1の透明膜12の厚さと、これらのバ ラメータを最適な値に設定すればよい。

【0035】光電変換部(N型拡散層05)毎に設けら れたレンズが表面から突き出た形になっていないので傷 損をうけにくい。又、フォトレジスト膜などに比較して 硬い酸化シリコン膜や窒化シリコン膜を使用しているの でゴミが付着しても除去し易い(硬度の高い窒化シリコ ン膜をカバー膜として全面を覆うと一層よい。)。更に ケースに組み立てる場合、カバー膜19上に空間を設け る必要はなく、例えば樹脂封止を行なうことができ低コ 20 に、屈折率が透明膜12Bより高い透明膜16Bを有 スト比に適している。

【0036】図3は本発明の固体撮像素子の第2の実施 の形態を示す断面図である。

【0037】本実施の形態では、凹部15-1Aに、表 面に凹部15-2を有する透明膜18を埋設し、凹部1 5-2に透明膜16Aを埋設している。透明膜16Aの 表面は平坦とする。透明膜16Aは凹部15-1A, 1 5-2の中心に近づくほど厚みを増している。この実施 の形態の製造方法について説明する。第1の実施の形態 と同様にして透明膜 1 2 A、凹み 1 5 - 1 A の形成まで 30 を行なう。

【0038】次に、例えばシリカガラスを形成するため の塗布液を用いて塗布膜を全面に形成しベークし、透明 膜18(SOG膜)を形成する。これにより、半球状で あった凹部15-1は透明膜18により下部が埋設され 浅くなり、楕円体状の凹部15-2になる。つぎに窒化 シリコン膜などの透明膜16Aを凹部15-2に埋設 し、好ましくは表面を平坦化する。次に必要があればカ バー膜19を形成する。

化シリコン膜と透明膜 18のSOG膜とは、屈折率がほ ぼ等しく、また透明膜 16 Aの窒化シリコン膜の屈折率 が高い。そのため、透明膜16Aのみがレンズとしては

【0040】シリカ塗布直後は塗布膜上面は平坦である が、ベークなどにより収縮すると、凹部15-2が形成 される。すなわち、凹部15-1Aの断面がほぼ半円形 状であるのに対し、凹部15-2の断面形状は、例えば シリカ塗布膜の収縮率が1/2であれば、長径・短径の 比が2の楕円形となる。このためレンズの曲率半径は、

凹部15-1Aに直接透明膜16を埋設した第1の実施 の形態に比べ約2倍となり、焦点距離も約2倍となる。 シリカ塗布膜をベークしてSOG膜化するときの収縮率 はシリカガラス膜を形成するための塗布液の含水量など の調整することにより簡単に変更できるので、レンズの 焦点距離は容易に調整することが可能である。また必要 ならばこのシリカ塗布・ベークの作業を複数回行っても 焦点の調整をおこなってもよい。

【0041】これによって、第1の実施の形態の場合の の曲率半径、透明膜12Aの厚さに加え、透明膜18と 透明膜16Aの屈折率と、両者の厚さ(凹部15-2)、及び透明膜12Aの厚さによっても焦点を調整す ることができる。これにより、よりきめ細かい焦点調整 が可能になり(設計の自由度が増し)、制御性が向上し

【0042】次に本発明の第3の実施の形態について図 4を参照しながら説明する。本発明の第3の実施の形態 の固体撮像素子は、透明膜12Bの凹部15-1Bの中 し、透明膜16日は上部が凹状で、また透明膜16日の 厚さは凹部 15-1 Bの中心に近づくほど厚くなってい

【0043】この実施の形態の製造方法について次に説 明する。第1の実施の形態と同様にして透明膜12B, 凹部15-1Bの形成までを行なう。つぎに、屈折率 が、透明膜12B(酸化シリコン膜)に比べ高いガラス 膜を形成するための塗布液、たとえばTiO2(屈折率 は2.3~2.5) やSrTiO3とシリカガラスとの 混合物などを含む塗布液を塗布し、ベークし、透明膜1 6 Bを形成する。次に、必要があればカバー膜19を形 成する。

【0044】本実施の形態の場合も、第2の実施の形態 と同様に塗布膜をベークしてガラス化するときの収縮率 を変えることにより、容易にレンズの焦点調整ができ

【0045】本実施の形態では透明膜16B又はカバー 膜19Aの表面は平坦にならないが、レンズ作用をなす 透明膜16日と透明膜12日との界面は露出していない 【0039】この実施の形態の場合、透明膜12Aの酸 40 のでレンズの損傷は受け難い。又、樹脂封止などを行な っても、透明膜 16 Bの表面の凹部の曲率は大きく、カ バー膜19A上に空間を設けないことによる焦点距離の 変化は小さく、予めそれを考慮して設計しておけばよ

> 【0046】第2および第3の実施の形態において用い たシリカガラス系の透明膜の代りに、低融点ガラスのよ うに、塗布時に液状で、後で固化し、収縮するものであ れば使用できる。

【0047】次に第4の実施の形態を図5を参照しなが 50 ら説明する。

【0048】第4の実施の形態の固体撮像素子は、透明 膜120の表面の凹部15-10に埋設する透明膜16 Cの断面が楕円形状をしている。これは透明膜16Cと して質の異なる多層膜や質が連続的に変化しているもの を用いることにより形成できる。すなわち、第1の実施 例と同様にして絶縁膜11の堆積までを行なう。

【0049】つぎに、CVD(化学的気相成長)法等に より、酸化シリコン膜を堆積し、透明膜12Cを形成す る。このとき、透明膜12Cの表面付近のリン濃度が高 くなるようにする。方法としては、ノンドープの酸化シ リコン膜堆積後にイオン注入法などによりリンを導入す るか、酸化シリコン膜堆積の際に、シラン系ガスととも にホスフィン(PH3)などのリン含有物を添加する量 を制御することにより、リン濃度が表面から厚さ方向に 単調に減少する酸化シリコン膜を堆積することができ る。つぎに、図6(a)に示すように、フォトレジスト 膜13によりN型拡散層05の直上に小さな開口14を 設ける。つづいて、希フッ酸溶液などにより透明膜12 Cを等方性エッチングを行う。このとき、透明膜12C のエッチングレートは、図6(b)に示すように、深く 20 れて焦点距離等を設計しておけばよい。 なるにしたがい遅くなるので、凹部15-10の形状 は、第1の実施の形態のように透明膜12のエッチレー トが等しい場合は図7に示すように凹部15-1はほぼ 半球状ないしかまぼと状になるのに対して、図6 (a) に示すように上下に押しつぶされたようなほぼ楕円体に なる。凹部15-10の形状は透明膜120へのイオン 注入条件やリンソース添加条件により調整することがで きる。

【0050】つぎに凹部15-1Cに透明膜16Cを埋 設し、上面を平坦化しレンズを形成する。透明膜 160 は窒化シリコン膜など透明膜12Cより屈折率の高いも のを使用する。つぎに透明膜16Cの L部をCMP法な どにより平坦化するのが好ましい。つぎに必要があれば カバー膜19を形成する。

【0051】以上説明した各実施の形態の固体撮像素子 において、単板式カラーカメラに用いる場合、各画素に 着色したカラーフィルターを形成する必要があるが、そ の場合は絶縁膜11と透明膜16,16A等の間に形成 するか、透明膜16,16A等の上に形成すればよい。 【0052】図8(a)は本発明の固体撮像装置の第1 の実施の形態の平面図、図8(b)は図8(a)のX-X線断面図である。

【0053】本発明の固体撮像素子の第1~第4の実施 の形態のいずれか一つが作り込まれた固体撮像素子チッ プ25 (複数の画素列が並列配置された撮像領域 [A が ほぼ中央部に設けられている。IAに隣接して、図示し ない水平CCDレジスタや増幅器等が設けられているも のとする。) の周囲を覆って透明樹脂28で封止されて いる。固体撮像素子チップ25と透明樹脂28は図示の ように直接接していてもよいし、固体撮像素子チップ表 50 てる必要がないのでケースが簡素化でき、コスト低減が

面保護のためシリコーン樹脂等を間にはさんでもよい。 カラーフィルターを使用した場合もカラーフィルター上 面は平坦になるので適用可能である。

【0054】次に、本実施の形態の固体撮像装置の製造 方法をしめす。まず、固体撮像素子チップ25をリード フレームのアイランド31にマウントして、次にボンデ ィングワイヤー27で固体撮像素子チップ上の各端子 (パッド) とピン26-1 (アイランド31に連結して いる)、26-2(アイランド31とは切り離されてい る)とをそれぞれ接続する。次に、透明樹脂28により 封止し、ピン26-1、26-2をフレームから切り離 し、ピンの折り曲げを行なう。

【0055】前述した本発明の固体撮像素子の第1,第 2, 第4の実施の形態では平面が平坦であるので、透明 樹脂膜28の屈折率が透明膜16,16A,16Cと異 なっていてもレンズ作用に影響はない。第3の実施の形 態では多少の影響はあるが、透明膜16Bの上面の曲率 が凹部15-1Bの曲率より大きいのでレンズ作用は失 われないので、透明樹脂28による影響を予め考慮に入

【0056】固体撮像素子チップの上面に空間を設ける 必要がなく、直接透明樹脂等を接触させることができる ので、樹脂封止可能であり安価に製造できる。

【0057】図9(a)は本発明の固体撮像装置の第2 の実施の形態を示す平面図、図9(b)は図9(b)の X-X線断面図である。

【0058】 これは透明樹脂28A (樹脂封止材)の表 面を凸状にして固定焦点レンズ29を設け、またレンズ 29以外の透明樹脂28A表面を遮光膜30 (絶縁性の 黒色塗料)で覆っている。製造方法は、透明樹脂28A 形成時にレンズ29も一緒にモールド形成する。そのあ と、レンズ面以外の透明樹脂表面に遮光膜30を形成す ればよい。

【0059】固定焦点レンズを撮像レンズとして使用で きるので、簡易型カメラとして好適である。なお、樹脂 封止材で固定焦点レンズを構成する代りに、ガラス製の レンズを貼り付けてもよい。

【0060】以上、CCD型固体撮像素子及びCCD型 固体撮像装置を例にして説明したが、MOS型などそれ 以外の固体撮像素子及び固体撮像装置にも本発明は適用 可能である。

[0061]

【発明の効果】本発明の固体撮像素子は、第1の透明膜 と第1の凹部を設けて第2の透明膜を埋設したレンズを 有しているのでレンズが突出していないので機械的損傷 をうけにく、ゴミ付着しても、ブロワーなどを使い簡単 に除去できる。このため製造ラインはクリーン度が低く てもすみコストが低減できる。また表面が平坦もしくは ほぼ平坦であるので、上面に空間を有してケースに組立

12

可能である。更に、透明樹脂で封止して固定焦点レンズ を設ければ、簡易型カメラを安価に提供できる。

11

【0062】また、レンズを窒化シリコン膜などの樹脂膜に比べて硬い無機物で構成することにより機械的強度や耐熱性を向上できる。更に全面を硬度の高いカバー膜で被覆しておくことができるので、機械的損傷に一層強くすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の固体撮像素子の第1の実施の形態を示す平面図(図1(a)) および図1(a)のX-X線断 10面図(図1(b))である。

【図2】本発明の固体撮像素子の第1の実施の形態の製造方法について説明するための(a)~(c)に分図して示す工程順断面図である。

【図3】本発明の固体撮像素子の第2の実施の形態を示す断面図である。

【図4】本発明の固体撮像素子の第3の実施の形態を示す断面図である。

【図5】本発明の固体撮像素子の第4の実施の形態を示す断面図である。

【図6】本発明の固体撮像素子の第4の実施の形態の製造法について説明するための断面図(図6(a))及びグラフ(図6(b))である。

【図7】本発明の固体撮像素子の第4の実施の形態の製造方法について説明するための断面図(図7(a))及びグラフ(図7(b))である。

【図8】本発明の固体撮像装置の第1の実施の形態の平面図(図8(a))及び図8(a)のX-X線断面図(図8(b))である。

【図9】本発明の固体撮像装置の第2の実施の形態の平 30 27 面図(図9(a))及び図9(a)のX-X線断面図で 28, ある。 29

【図10】固体撮像素子の第1の従来例を示す断面図である。

*【図11】固体撮像素子の第2の従来例を示す断面図で . ある。

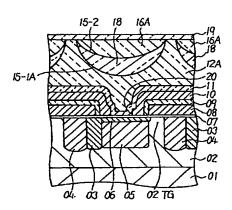
【符号の説明】

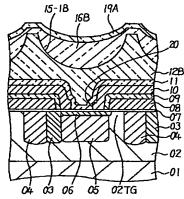
- 01 N型シリコン基板
- 02 Pウェル
- 03 素子分離領域
- 04 電荷転送領域
- 05 N型拡散層(光電変換部)
- 06 P+型拡散層
- 07 ゲート絶縁膜
 - 08 第1の電荷転送電極
 - 09 酸化シリコン膜
 - 10 遮光膜
 - 11 絶縁膜
 - 12, 12A, 12B, 12C 透明膜
- 13 フォトレジスト膜
- 14 開口
- 15-1, 15-1A, 15-1B, 15-1C, 15
- -2 四部
- 20 16, 16A, 16B, 16C 透明膜
 - 18 透明膜
 - 19 カバー膜
 - 20 開口
 - 21 平坦化層
 - 22 オンチップレンズ
 - 23 シリカガラス
 - 24 凸レンズ
 - 25, 25A 固体撮像素子チップ
 - 26-1,26-2 ピン
- 0 27 ボンディングワイヤ
 - 28, 28A 透明樹脂
 - 29 レンズ
 - 30 遮光膜
 - 31 アイランド

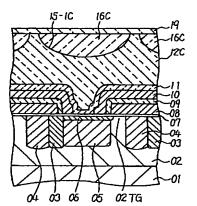
【図3】

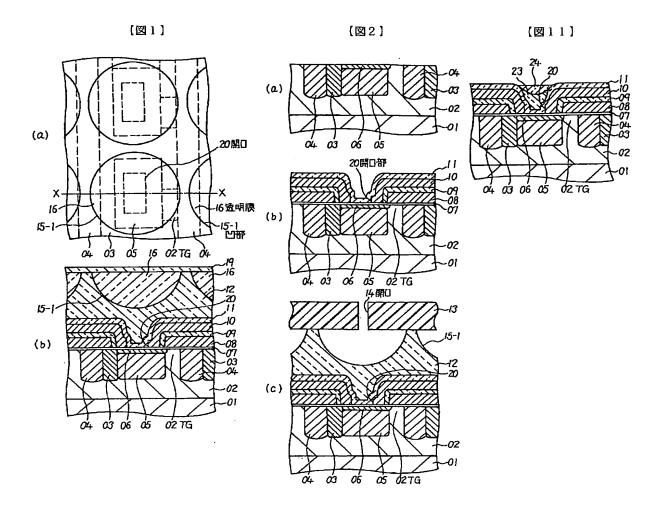
【図4】

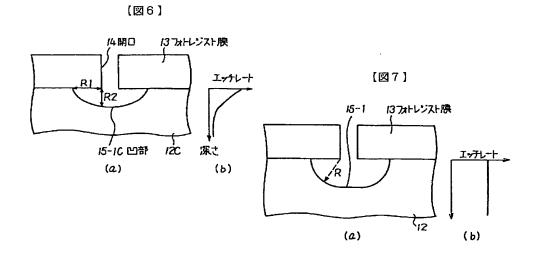
【図5】



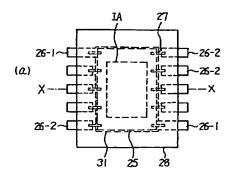


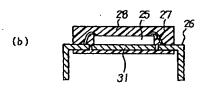




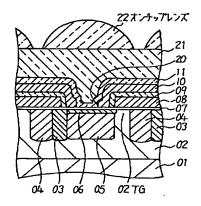


【図8】





【図10】



【図9】

